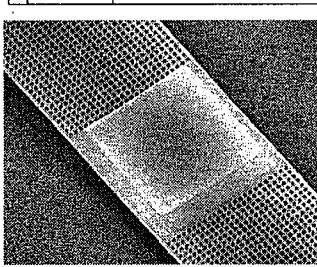


温度差で半導体駆動

東京大学の野村政宏准教授らは、シリコン製の半導体素子を周囲の温度差だけで駆動させる研究に取り組んでいます。トンネルや橋などインフラの割れや腐食を検出するセンサーに応用すれば、電源の確保や電池交換が不要になる。実現にはシリコン薄膜の一部に熱が伝わりにくい微小構造を作り、発電に必要な大きな温度差が生じるようにする必要がある。「音子(フォノン)」と呼ぶ振動を使って道を開こうとしている。

半導体に使う粒子	
用途	特徴
電子(エレクトロン)	電気や磁気の性質があり制御しやすい。信号が弱くなりやすい
演算、記憶、伝送	
光子(フォトン)	信号が弱くなりにくく、一度に大量のデータを送れる。制御が難しい
伝送	
音子(フォノン)	電子や光子に無い性質がある。制御が難しく研究段階
発電、放熱	



東大、実用化へ

フォノン制御発電に活用

昨年12月、東大グループはシリコンを加工して100ナノ(ナノは10億分の1)メートルの複雑構造を作り、熱伝導率を約20分の1に下げるに成功した。熱はシリコンなどの固体中の振動であるフォノンが生みだす。熱伝導率はフォノンの伝わりやすさを示し、これが下がるほどシリコンの内部に大きな温度差が生じる。東大はドイツのフライブルク大学と組み、2年内に温度差に

今回の成果で、センサーの駆動に必要な電力を生み出せる可能性がみえてきた。東大はドライバーチップを用いて、シリコン薄膜(東大提供)

昨年12月、東大グループはシリコンを加工して100ナノ(ナノは10億分の1)メートルの複雑構造を作り、熱伝導率を約20分の1に下げるに成功した。熱はシリコンなどの固体中の振動であるフォノンが生みだす。熱伝導率はフォノンの伝わりやすさを示し、これが下がるほどシリコンの内部に大きな温度差が生じる。東大はドライバーチップを用いて、シリコン薄膜(東大提供)

昨年12月、東大グループはシリコンを加工して100ナノ(ナノは10億分の1)メートルの複雑構造を作り、熱伝導率を約20分の1に下げるに成功した。熱はシリコンなどの固体中の振動であるフォノンが生みだす。熱伝導率はフォノンの伝わりやすさを示し、これが下がるほどシリコンの内部に大きな温度差が生じる。東大はドライバーチップを用いて、シリコン薄膜(東大提供)

視点

(フォトン)が使われる。処理する情報量が増すにつれ、熱をうまく制御できれば、電子より大量のデータを一度に送れる光の粒である光子(フォトン)の利用が進んでいる。

これまで半導体を支える「第4の柱」と期待されている。フォノンの熱を伝える性質を利用すれば、半導体で発生した熱を逃がすことや、熱をどう利用するかで、発電するなど新しい用途が生まれる可能性がある。

固体や気体中で熱や音を伝える振動を構成する。それ以上分割できない最小単位の粒子(量子)を音子(フォノン)と呼ぶ。音響量子という呼び方もある。人の感覚では、フォノンの振動する周波数が高い場合は熱として、低い場合は音として感じられる。

従来の半導体は主に電気の粒(電子)で信号処理する技術として発展してきた。そのため半導体を組み込んだ装置を電子機器と呼ぶ。演算処理したデータの記憶には電子の磁石(スピニ)の性質が使わ

省エネ効果の可能性も

身の回りにある様々な機器の多くは電気で動いている。電気は電子と呼ぶ粒の集まりで、電子は負の電荷や磁石の

性質を持つため比較的制御しやすい。電機産業がこれほど大きく成長したのは、電気が扱いやすいからだ。

従来の半導体は主に電気の粒(電子)で信号処理する技術として発展してきた。そのため半導体を組み込んだ装置を電子機器と呼ぶ。演算処理したデータの記憶には電子の磁石(スピニ)の性質が使われた。音子(フォノン)はまだほとんど使われていない。国内外の研究者数も少ない。国内外の研究者数も少ない。国内外の研究者数も少ない。

NTT物性科学基礎研究所の山口浩司上席特別研究員らも、フォノンを精密に制御する研究に取り組む。半導体の基板に幅30 nm(詰めは100万分の1)の特殊な構造の

NTT物性科学基礎研究所の山口浩司上席特別研究員らも、フォノンを精密に制御していく。そこで、材料内部のフォノンの伝わりやすさで、ある熱伝導率を人工的に下げ、大きな温度差が生じる。NTT物性科学基礎研究所の山口浩司上席特別研究員らも、フォノンを精密に制御する研究に取り組む。半導体の基板に幅30 nm(詰めは100万分の1)の特殊な構造の

NTT物性科学基礎研究所の山口浩司上席特別研究員らも、フォノンを精密に制御する研究に取り組む。半導体の基板に幅30 nm(詰めは100万分の1)の特殊な構造の

センサー普及に対応

NTT物性科学基礎研究所の山口浩司上席特別研究員らも、フォノンを精密に制御する研究に取り組む。半導体の基板に幅30 nm(詰めは100万分の1)の特殊な構造の

NTT物性科学基礎研究所の山口浩司